

# 2SD1571

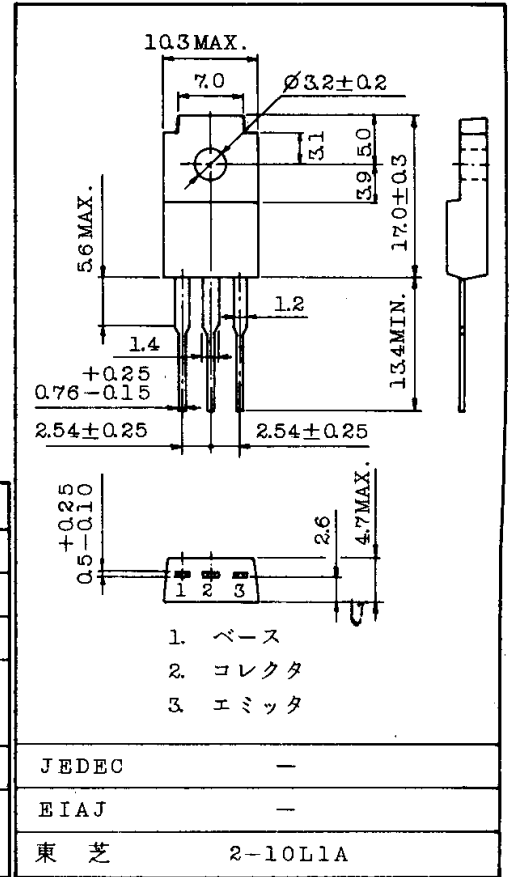
シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ

○ 高電圧スイッチング用

特 長

- ・ 高耐圧です。 :  $V_{CB0} = 800V$
- ・ 飽和電圧が低い。 :  $V_{CE(sat)} = 1.0V$  (最大)  
( $I_C = 0.5A, I_B = 0.05A$ )
- ・ スwitching時間が速い。 :  $t_f = 1.0\mu s$  (最大)
- ・ 絶縁ブッシング, マイカ等が不要なTO-220相当のアイソレーションパッケージです。

単位: mm



最大定格 ( $T_c = 25^\circ C$ )

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	800	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	400	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流	DC	$I_C$	3
	パルス	$I_{CP}$	6
ベース電流	$I_B$	1.5	A
コレクタ損失	$T_a = 25^\circ C$	$P_C$	2.0
	$T_c = 25^\circ C$		30
接 合 温 度	$T_j$	150	$^\circ C$
保 存 温 度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	$^\circ C$

JEDEC —  
EIAJ —  
東 芝 2-10L1A

電気的特性 ( $T_c = 25^\circ C$ )

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタしゃ断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB} = 800V, I_E = 0$	—	—	1	mA
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	—	—	1	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10mA, I_B = 0$	400	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 10mA$	8	—	—	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 0.5A$	10	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 0.5A, I_B = 0.05A$	—	—	1.0	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 0.5A, I_B = 0.05A$	—	—	1.5	V
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	75	—	pF
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = 10V, I_E = -0.1A$	—	4	—	MHz
下 降 時 間	$t_f$	<p> <math>20\mu s</math>  <math>V_{CC} = 200V</math>  <math>I_{B1}</math> 入力  <math>I_{B2}</math> 出力  <math>I_C = 0.5A</math>  <math>I_{B1} = -I_{B2} = 0.05A</math>            繰り返し周期 &lt; 2%         </p>	—	—	1.0	$\mu s$